

Pチャンネル MOS FET
高速度スイッチング用

2SJ179は、Pチャンネル縦形MOS FETで、5V電源系ICから直接駆動が可能なスイッチング・デバイスです。

オン抵抗が低く、電圧駆動タイプであるためアクチュエータ(モータ、ソレノイド、リレー等)のドライブに最適です。

特 徴

○低オン抵抗です。

$$R_{DS(on)} = 1.5 \Omega \text{ (MAX.) @ } V_{GS} = -4 \text{ V, } I_D = -0.5 \text{ A}$$

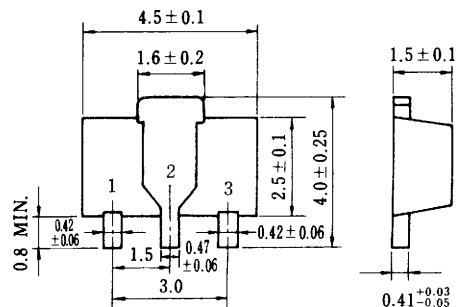
$$R_{DS(on)} = 1.0 \Omega \text{ (MAX.) @ } V_{GS} = -10 \text{ V, } I_D = -0.5 \text{ A}$$

○ロジックレベルの電圧駆動 ($V_{GS} = -4 \text{ V}$) が可能です。

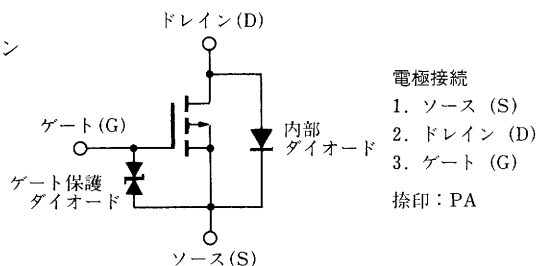
○ゲート・ソース間に保護用として双方向ツェナーダイオードを内蔵しています。

○ドレイン・ソース間耐量が向上しているため保護回路なしにインダクタンス負荷が動作できます。

外形図 (単位: mm)



等価回路



上図中の内部ダイオードは、寄生ダイオードです。保護ダイオードは、取り扱い上における静電破壊保護のためのものです。

実使用回路で、ゲート・ソース間に過大な電圧が印加される危険性がある場合は、外付け定電圧ダイオードなどのゲート保護回路が必要です。

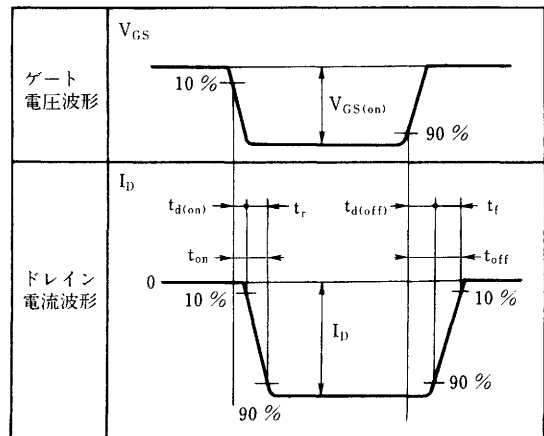
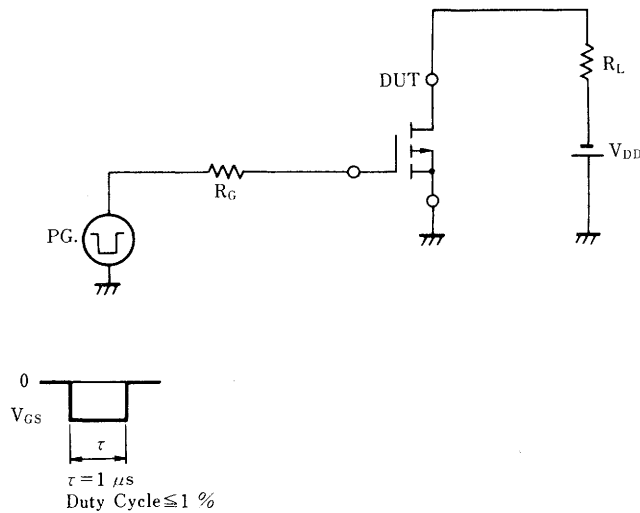
絶対最大定格 ($T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	$V_{GS} = 0$	-30	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	$V_{DS} = 0$	± 20	V
ドレイン電流(直 流)	$I_{D(DC)}$		± 1.5	A
ドレイン電流(パルス)	$I_{D(pulse)}$	$PW \leq 10 \text{ ms}$ $Duty \text{ Cycle} \leq 50 \%$	± 3.0	A
全 損 失	P_T	16 $\text{cm}^2 \times 0.7 \text{ mm}$ セラミック基板使用時	2.0	W
チ ャ ネ ル 温 度	T_{ch}		150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}		-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

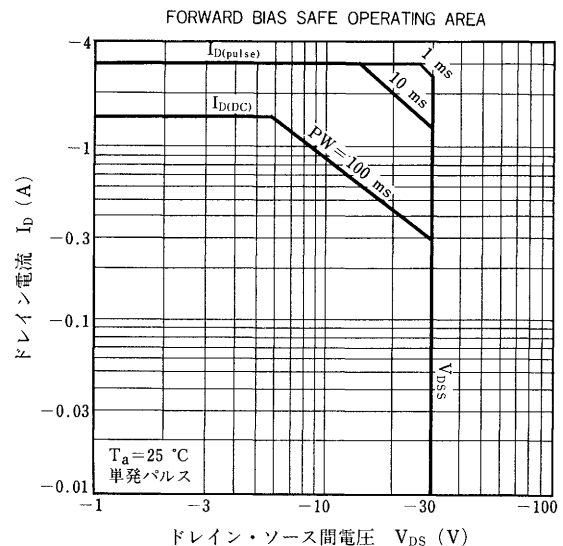
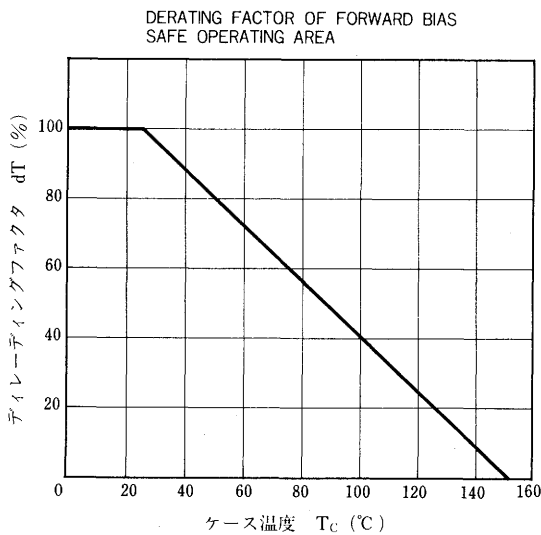
電気的特性 (T_a = 25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレインシャ断電流	I _{DSS}	V _{DS} = -30 V, V _{GS} = 0			-10	μA
ゲート漏れ電流	I _{GSS}	V _{GS} = ±20 V, V _{DS} = 0			±10	μA
ゲートカットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = -10 V, I _D = -1 mA	-1.0	-2.2	-3.0	V
順伝達アドミタンス	y _{fs}	V _{DS} = -10 V, I _D = -0.5 A	0.4			S
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(on)1}	V _{GS} = -4 V, I _D = -0.5 A		0.8	1.5	Ω
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(no)2}	V _{GS} = -10 V, I _D = -0.5 A		0.4	1.0	Ω
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = -10 V V _{GS} = 0, f = 1 MHz		210		pF
出力容量	C _{oss}			130		pF
帰還容量	C _{rss}			3		pF
オン時遅延時間	t _{d(on)}	I _D = -0.5 A, R _L = 50 Ω V _{GS(on)} = -10 V R _G = 10 Ω, V _{DD} = -25 V		35		ns
立ち上がり時間	t _r			70		ns
オフ時遅延時間	t _{d(off)}			380		ns
下降時間	t _f			200		ns

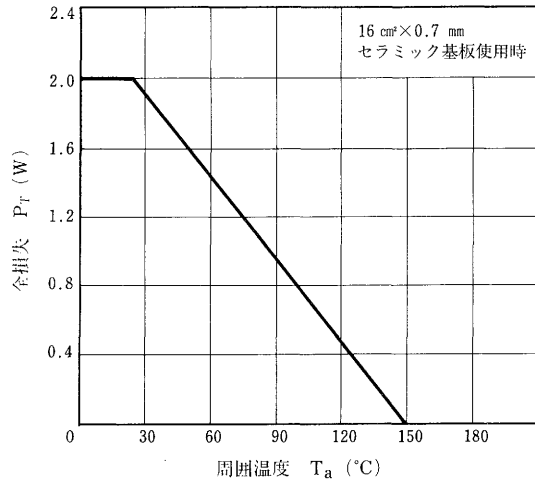
スイッチングタイム測定回路, 測定条件



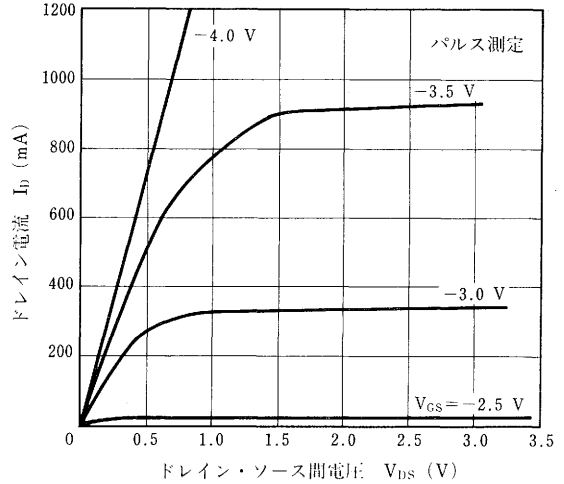
特性曲線 (T_a = 25 °C)



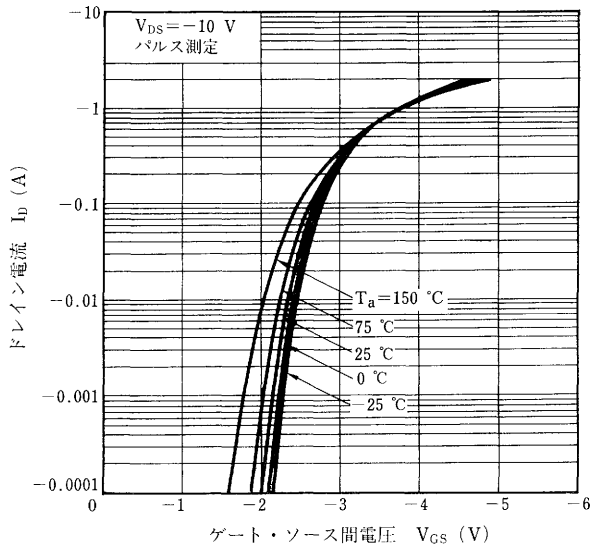
TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE



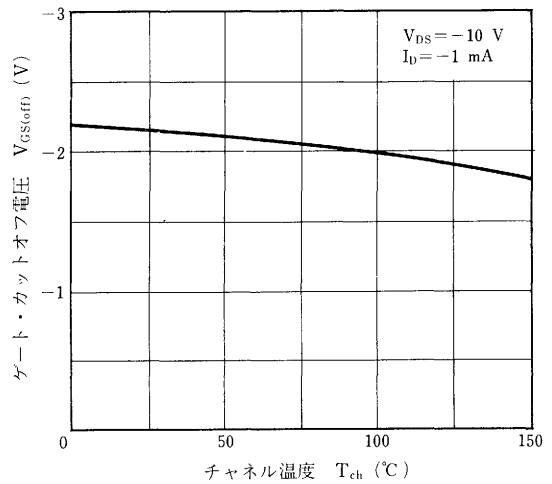
DRAIN CURRENT vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE



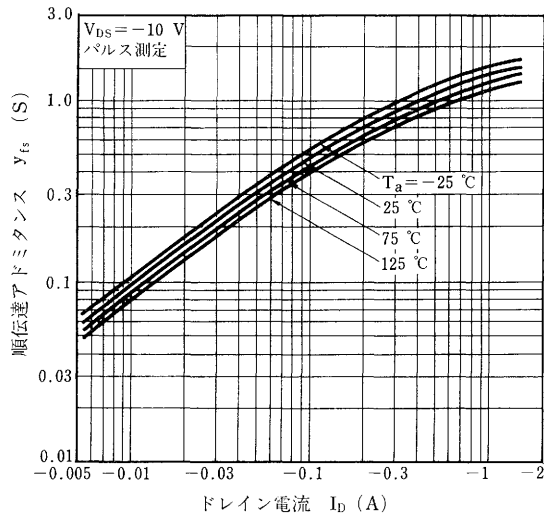
TRANSFER CHARACTERISTICS



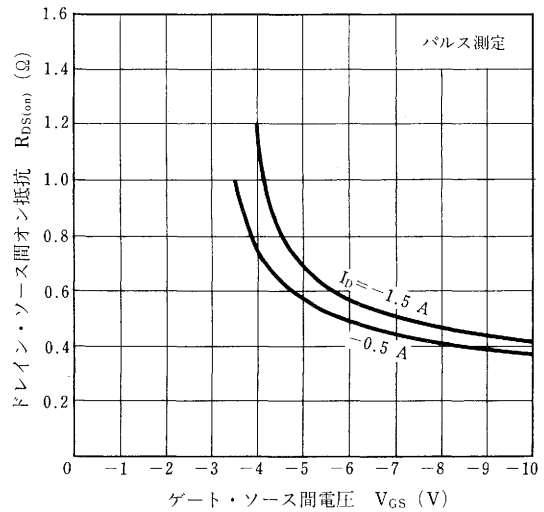
GATE TO SOURCE CUTOFF VOLTAGE vs. CHANNEL TEMPERATURE

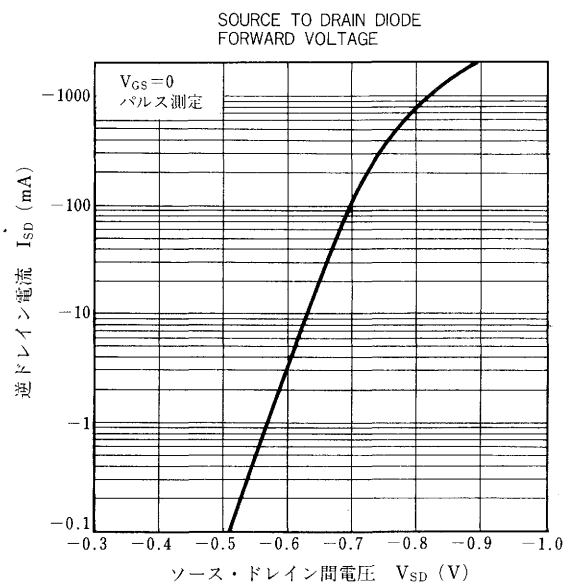
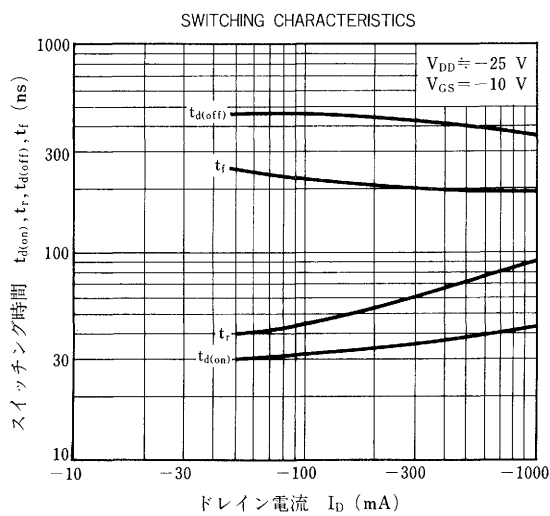
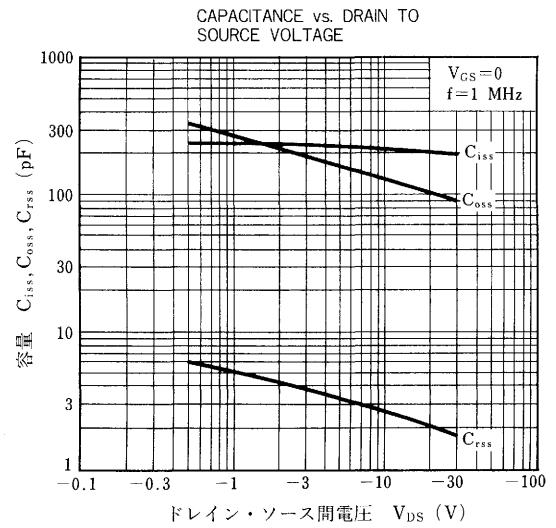
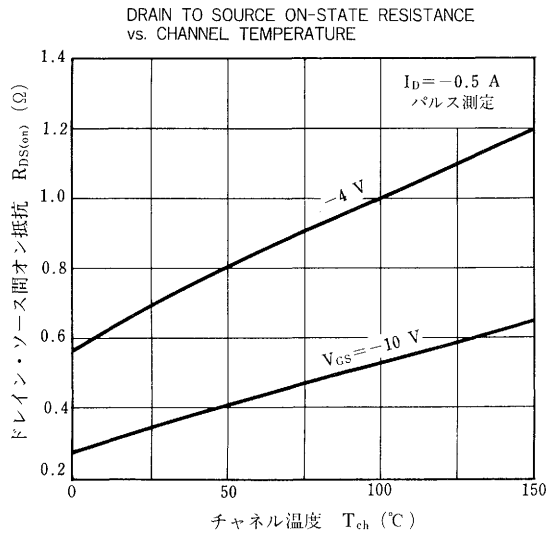
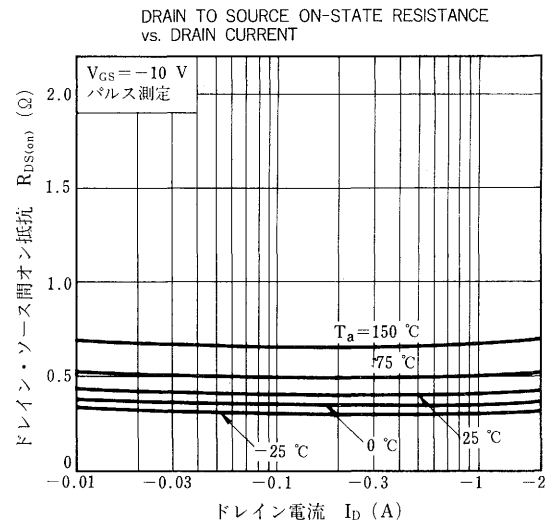
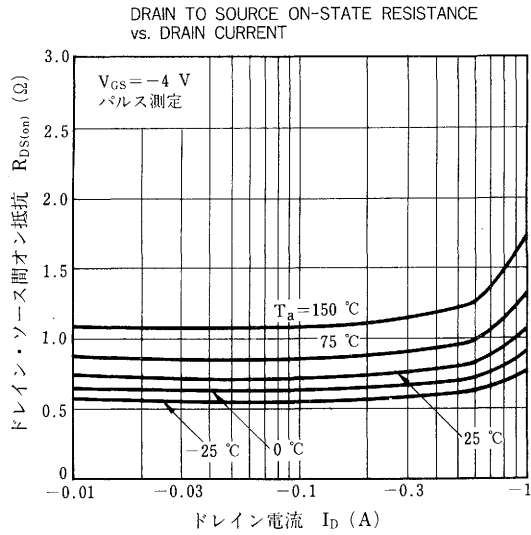


FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs. DRAIN CURRENT



DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. GATE TO SOURCE VOLTAGE





半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

表面実装タイプ

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「表面実装用デバイス実装マニュアル」(IEI-616)をご参照ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
(※注) 赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：230℃，時間：30秒以内(210℃以上)，回数：1回 制限日数：なし*	IR30-00
VPS	パッケージ・ピーク温度：215℃，時間：40秒以内(200℃以上)，回数：1回 制限日数：なし*	VP15-00
ウェーブ・ソルダリング	半田槽温度：260℃以下，時間：10秒以内，回数：1回 制限日数：なし*	WS60-00
端子部分加熱	端子部温度：300℃以下，時間：10秒以内，制限日数：なし*	○

*：ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は25℃，65%RH以下。

注1. 半田付け方式の併用はお避けください(ただし、端子部分加熱方式は除く)。

※注. 樹脂表面温度が基板温度より20℃以上高くないよう注意のこと。

参考資料

資料名	資料番号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイス パッケージ・マニュアル	IEI-635
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
半導体総合セレクション・ガイド	MF-212
パルス電力損失時におけるトランジスタの接合部温度の算出方法について	TEB-528
トランジスタのE-B接合ブレイクダウンによる h_{FE} 、ノイズ劣化	TEB-537

〔メ モ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.6

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111 (大代表)
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2755
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208
北海道支社 東北支社 岩手支店 山形支店 郡山支店 いわき支店 長岡支店 土浦支店 水戸支店 神奈川支社 群馬支店 太田支店 宇都宮支店	札幌 (011)231-0161 仙台 (022)261-5511 盛岡 (0196)51-4344 山形 (0236)23-5511 郡山 (0249)23-5511 いわき (0246)21-5511 長岡 (0258)36-2155 土浦 (0298)23-6161 水戸 (0292)26-1717 横浜 (045)324-5511 高崎 (0273)26-1255 北畠 (0276)46-4011 宇都宮 (0286)21-2281	小山支店 (0285)24-5011 長野支社 (0262)35-1444 松本支店 (0263)35-1666 上諏訪支店 (0266)53-5350 甲府支店 (0552)24-4141 埼玉支社 (048)641-1411 立川支社 (0425)26-5981 千葉支社 (043)238-8116 静岡支社 (054)255-2211 沼津支店 (0559)63-4455 浜松支店 (053)452-2711 北陸支社 (0762)23-1621 福井支店 (0776)22-1866
富山支店 三重支店 京都支社 神戸支社 中国支社 鳥取支店 岡山支店 四国支社 新居浜支店 松山支店 九州支社 北九州支店	富山 (0764)31-8461 津 (0592)25-7341 京都 (075)344-7824 神戸 (078)332-3311 広島 (082)242-5504 鳥取 (0857)27-5311 岡山 (086)225-4455 高松 (0878)36-1200 新居浜 (0897)32-5001 松山 (0899)45-4111 福岡 (092)271-7700 北九州 (093)541-2887	

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-7914	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2762	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3383	